

* Preferred device
 Dispositif recommandé

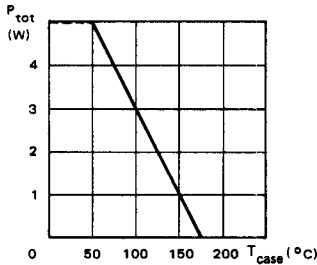
The NPN planar epitaxial transistors BF 257, BF 258 and BF 259 are intended for use in chrominance output stages and luminance output stage of colour television receivers.

Les transistors NPN planar au silicium BF 257, BF 258 et BF 259 sont particulièrement destinés aux étages de sortie des amplificateurs de chrominance R, V et B de l'amplificateur de luminance dans les récepteurs de télévision en couleur.

V_{CEO}	160 V to 300 V
C_{12e}	2,5 pF to 30 V
V_{CEsat}	25 V to 60 mA
$R_{th(j-c)}$	≤ 25 °C/W

Maximum power dissipation
 Dissipation de puissance maximale

Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
 Boîtier Voir dessin coté CB-7 dernières pages



Weight : 1 g.
 Masse

Collector is connected to case
 Le collecteur est relié au boîtier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
 VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

T_{amb} = + 25 °C

(Unless otherwise stated)
 (Sauf indications contraires)

			BF 257	BF 258	BF 259	
Collector-base voltage <i>Tension collecteur-base</i>		V_{CBO}	160	250	300	V
Emitter-base voltage <i>Tension émetteur-base</i>		V_{EBO}	5	5	5	V
Collector-emitter voltage <i>Tension collecteur-émetteur</i>		V_{CEO}	160	250	300	V
Collector current <i>Courant collecteur</i>		I_C	100	100	100	mA
Power dissipation <i>Dissipation de puissance</i>	T _{case} = 50 °C	P_{tot}	5	5	5	W
Junction temperature <i>Température de jonction</i>	max.	T_j	175	175	175	°C
Storage temperature <i>Température de stockage</i>	max.	T_{stg}	+ 175	+ 175	+ 175	°C

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

$T_{amb} = 25^{\circ}C$

(Unless otherwise stated)
 (Sauf indications contraires)

	Test conditions <i>Conditions de mesure</i>			Min.	Typ.	Max.	
Collector-base breakdown voltage <i>Tension de claquage collecteur-base</i>	$I_C = 100 \mu A$ $I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$	BF 257 BF 258 BF 259	160 250 300			V
Collector-emitter breakdown voltage <i>Tension de claquage collecteur-émetteur</i>	$I_C = 30 mA$ $I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	BF 257 BF 258 BF 259	160 250 300			V
Emitter-base breakdown voltage <i>Tension de claquage émetteur-base</i>	$I_E = 100 \mu A$ $I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$		5			V
Collector-base cut-off current <i>Courant résiduel collecteur-base</i>	$V_{CB} = 100 V$ $I_E = 0$	I_{CBO}	BF 257		50		nA
	$V_{CB} = 200 V$ $I_E = 0$		BF 258		50		nA
	$V_{CB} = 250 V$ $I_E = 0$		BF 259		50		nA
Static forward current transfer ratio <i>Valeur statique du rapport de transfert direct du courant</i>	$V_{CE} = 10 V$ $I_C = 30 mA$	h_{21E}		25			
Collector-emitter saturation voltage <i>Tension de saturation collecteur-émetteur</i>	$I_C = 30 mA$ $I_B = 6 mA$	V_{CEsat}			1		V

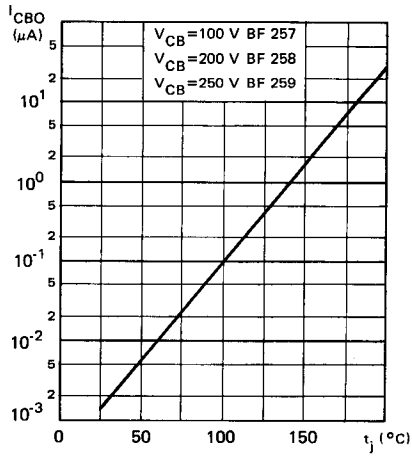
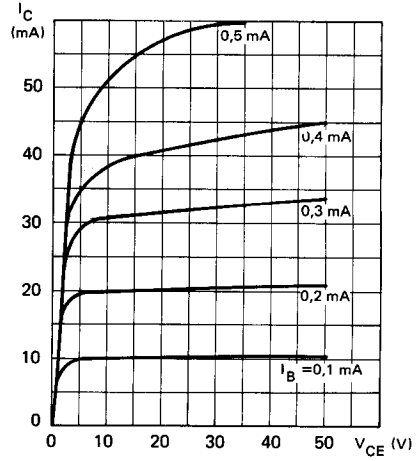
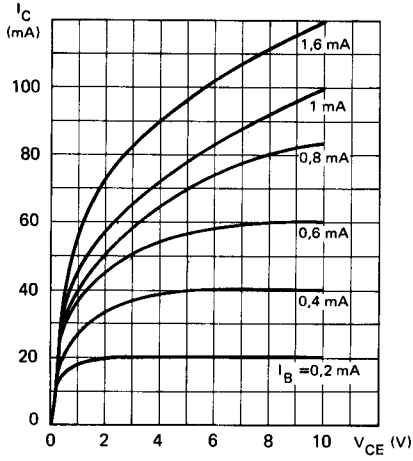
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

Output capacitance <i>Capacité de sortie</i>	$V_{CE} = 30 V$ $I_C = 0$	C_{22e}		3,5			pF
Reverse transfer capacitance <i>Capacité de transfert inverse</i>	$V_{CE} = 30 V$ $I_C = 0$ $f = 500 kHz$	C_{12e}		2,5			pF
Transition frequency <i>Fréquence de transition</i>	$V_{CE} = 10 V$ $I_C = 30 mA$	f_T		110			MHz

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance <i>Résistance thermique (jonction-boîtier)</i>		$R_{th(j-c)}$		17	25		$^{\circ}C/W$
------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	--	----	----	--	---------------

STATIC CHARACTERISTICS
 CARACTERISTIQUES STATIQUES



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

